

産総研出願特開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159

E-mail: aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2016年2月公開分(19件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2016-17010	モノハロシランの製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
2	特開2016-17054	アミノ酸のアミノ基及びカルボキシル基を対象としたプレカラム誘導体化LC-MS分析法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
3	特開2016-17071	ヒドロシラン化合物の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
4	特開2016-17760	センサ及び構造体	国立研究開発法人産業技術総合研究所
5	特開2016-18486	画像検索装置と画像検索プログラムと画像検索方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
6	特開2016-18586	燃料電池システム	ダイハツ工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
7	特開2016-19451	融雪機能を備えた太陽電池モジュールの電力配分回路	国立研究開発法人産業技術総合研究所
8	特開2016-19588	生体信号検出装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
9	特開2016-21465	半導体プロセス用キャリア	国立研究開発法人産業技術総合研究所 Carrier Integration株式会社
10	特開2016-23126	アンモニア態窒素含有廃棄物からのアンモニア分解水素製造方法	国立大学法人群馬大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所
11	特開2016-23128	グラフェン膜の製造装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
12	特開2016-23154	フラーレン誘導体およびこれを用いた有機光電変換素子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
13	特開2016-23334	マグネシウム系合金	株式会社戸畑製作所 国立研究開発法人産業技術総合研究所
14	特開2016-24094	打音検査装置	株式会社テクニ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
15	特開2016-25193	広帯域化高感度AEセンサー	国立研究開発法人産業技術総合研究所
16	特開2016-25258	不揮発性メモリ素子とその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
17	特開2016-27963	液浸インプリント方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
18	WO2013/187076	半導体基板、半導体基板の製造方法および複合基板の製造方法	住友化学株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
19	WO2013/187078	半導体基板、半導体基板の製造方法および複合基板の製造方法	住友化学株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所